

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

20.1.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年11月10日
Date of Application:

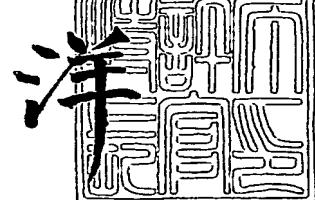
出願番号 特願2003-379784
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP2003-379784]

出願人 昭和電工株式会社
Applicant(s):

2004年10月27日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願
【整理番号】 1034649
【提出日】 平成15年11月10日
【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿
【国際特許分類】 C07C 7/12
【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県川崎市川崎区扇町5-1 昭和電工株式会社 ガス・化成品事業部 生産・技術統括部内
【氏名】 大野 博基
【特許出願人】
【識別番号】 000002004
【氏名又は名称】 昭和電工株式会社
【代理人】
【識別番号】 100099759
【弁理士】
【氏名又は名称】 青木 篤
【電話番号】 03-5470-1900
【選任した代理人】
【識別番号】 100077517
【弁理士】
【氏名又は名称】 石田 敬
【選任した代理人】
【識別番号】 100086276
【弁理士】
【氏名又は名称】 吉田 綜夫
【選任した代理人】
【識別番号】 100087413
【弁理士】
【氏名又は名称】 古賀 哲次
【選任した代理人】
【識別番号】 100082898
【弁理士】
【氏名又は名称】 西山 雅也
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 209382
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 0200971

【書類名】特許請求の範囲**【請求項1】**

分子内に2個の炭素原子を含む不飽和化合物類および分子内に2個の炭素原子を含む飽和含塩素化合物類からなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物を含有する粗1, 1-ジフルオロエタンと、平均細孔径が3～6Åであり、かつ、シリカ／アルミニウム比が2.0以下であるゼオライトおよび／または平均細孔径が3.5～6Åである炭素質吸着剤とからなる吸着剤を接触させ、粗1, 1-ジフルオロエタン中に不純物として含まれる前記化合物の含有量を低減させることを特徴とする1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

【請求項2】

分子内に2個の炭素原子を含む不飽和化合物類が、エチレン、フルオロエチレン、塩化ビニルおよび塩化ビニリデンからなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物である請求項1に記載の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

【請求項3】

分子内に2個の炭素原子を含む飽和含塩素化合物類が、ジクロロエタン、1-クロロ-1-フルオロエタンおよび2-クロロ-1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタンからなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物である請求項1に記載の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

【請求項4】

粗1, 1-ジフルオロエタン中に不純物として含まれる前記化合物の総含有量が0.1v o l %以下である請求項1～3のいずれかに記載の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

【請求項5】

粗1, 1-ジフルオロエタンと前記吸着剤とを接触させる圧力が1MPa以下である請求項1～4のいずれかに記載の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

【請求項6】

精製された1, 1-ジフルオロエタン中に不純物として含まれる前記化合物の総含有量が100v o l p p m以下である請求項1～5に記載の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

【請求項7】

精製された1, 1-ジフルオロエタン中に不純物として含まれる分子内に2個の炭素原子を含む不飽和化合物類の総含有量が50v o l p p m以下である請求項1～6のいずれかに記載の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

【請求項8】

精製された1, 1-ジフルオロエタン中に不純物として含まれる分子内に2個の炭素原子を含む飽和含塩素化合物類の総含有量が50v o l p p m以下である請求項1～7のいずれかに記載の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

【請求項9】

粗1, 1-ジフルオロエタンが以下の(1)～(3)の工程を含む方法により得られたものである請求項1～8のいずれかに記載の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

(1) 1, 1-ジクロロエタンおよび／または1-クロロ-1-フルオロエタンとフッ化水素とを、フッ素化触媒の存在下に反応させて、主として1, 1-ジフルオロエタンを得る工程

(2) 工程(1)で得られた1, 1-ジフルオロエタンを含む生成物中より、フッ化水素、1, 1-ジクロロエタンおよび／または1-クロロ-1-フルオロエタンを分離し、反応工程に循環する工程

(3) 工程(1)で得られた1, 1-ジフルオロエタンを含む生成物中より、塩化水素および／または1, 1-ジフルオロエタンを蒸留し、分離する工程

【請求項10】

請求項1～9のいずれかに記載の方法を用いて精製された1, 1-ジフルオロエタンであって、含有される水分が5v o l p p m以下である1, 1-ジフルオロエタン製品。

【請求項11】

請求項1～9のいずれかに記載の方法を用いて精製された1, 1-ジフルオロエタンであって、含有されるフッ化水素が2 v o l p p m以下である1, 1-ジフルオロエタン製品。

【請求項12】

請求項10または11に記載の1, 1-ジフルオロエタン製品を含むことを特徴とする冷媒。

【請求項13】

請求項10または11に記載の1, 1-ジフルオロエタン製品を含むことを特徴とするエッティングガス。

【書類名】明細書

【発明の名称】1, 1-ジフルオロエタンの精製方法およびその用途

【技術分野】

【0001】

本発明は1, 1-ジフルオロエタンの精製方法およびその用途に関する。

【背景技術】

【0002】

1, 1-ジフルオロエタン (CH_3CHF_2) は、例えば、低温用冷媒やエッチングガスとして注目されている。

【0003】

1, 1-ジフルオロエタンの製造方法としては、従来より次のような方法が知られている。例えば、(1) クロロエチレン ($\text{CH}_2=\text{CHCl}$) や1-クロロ-1-フルオロエタン等を気相でフッ素化触媒を用いてフッ素化する方法(欧州特許出願公開第0370688号公報)、(2) 塩素化フッ素化炭化水素を触媒の存在下に水素で還元して製造する方法(特開平7-126197号公報)等が挙げられる。

【0004】

これらの方法を用いて製造された CH_3CHF_2 ($\text{HFC}-152\text{a}$) は、ハイドロカーボン (HC) 類、ハイドロクロロカーボン (HCC) 類、クロロフルオロカーボン (CFC) 類、ハイドロクロロフルオロカーボン (HCFC) 類、ハイドロフルオロカーボン (HFC) 類の飽和化合物や不飽和化合物等の様々な不純物を含んでいる。

【0005】

純度の高い CH_3CHF_2 を得るためにには、これらの不純物をできる限り除去する必要がある。特に、含塩素化合物であるハイドロクロロカーボン、クロロフルオロカーボン、ハイドロクロロフルオロカーボン等については、高純度化するということの他に、オゾン層の破壊を防止するという観点から、通常の蒸留では分離が困難な化合物でも精製して純度を上げる必要がある。前記の不純物の中には、 CH_3CHF_2 と共沸混合物や共沸様混合物を形成するため、 CH_3CHF_2 と分離することが非常に困難な化合物もある。

【0006】

例えば、冷媒として重要な化合物である1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタン ($\text{CF}_3\text{CH}_2\text{F}$) やペンタフルオロエタン (CF_3CHF_2) 等は、不純物を精製する方法として、例えば、抽出蒸留による精製や触媒の存在下で水素を用いた脱ハロゲン水素化方法等によって除去する精製方法が知られているが抽出蒸留によって精製する方法は、蒸留塔などの高価な設備を複数必要とするため、設備費が高くなる等の問題を有している。また、水素を用いる方法は、可燃物対応のため、設備費が高い、触媒寿命が短い等の問題を有している。

【0007】

【特許文献1】欧州特許出願公開第0370688号公報

【特許文献2】特開平7-126197号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

本発明は、このような背景の下に、低温用冷媒やエッチングガスとして使用することができる、高純度な1, 1-ジフルオロエタンを工業的に有利に製造することのできる方法を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明者らは、前記の課題を解決すべく鋭意検討した結果、分子内に2個の炭素原子を含む不飽和化合物類および分子内に2個の炭素原子を含む飽和含塩素化合物類からなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物を含有する粗1, 1-ジフルオロエタンと、平均細孔径が3~6 Åであり、かつ、シリカ/アルミニウム比が2.0以下であるゼオライトお

よび／または平均細孔径が3.5～6Åである炭素質吸着剤とからなる吸着剤を接触させ、粗1, 1-ジフルオロエタン中に不純物として含まれる前記化合物の含有量を低減させる方法を用いることにより前記の課題を解決することができることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0010】

よって、本発明は、例えば、以下の〔1〕～〔13〕に示される1, 1-ジフルオロエタンの精製方法およびその用途を提供する。

【0011】

〔1〕 分子内に2個の炭素原子を含む不飽和化合物類および分子内に2個の炭素原子を含む飽和含塩素化合物類からなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物を含有する粗1, 1-ジフルオロエタンと、平均細孔径が3～6Åであり、かつ、シリカ／アルミニウム比が2.0以下であるゼオライトおよび／または平均細孔径が3.5～6Åである炭素質吸着剤とからなる吸着剤を接触させ、粗1, 1-ジフルオロエタン中に不純物として含まれる前記化合物の含有量を低減させることを特徴とする1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

【0012】

〔2〕 分子内に2個の炭素原子を含む不飽和化合物類が、エチレン、フルオロエチレン、塩化ビニルおよび塩化ビニリデンからなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物である上記〔1〕に記載の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

【0013】

〔3〕 分子内に2個の炭素原子を含む飽和含塩素化合物類が、ジクロロエタン、1-クロロ-1-フルオロエタンおよび2-クロロ-1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタンからなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物である上記〔1〕に記載の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

【0014】

〔4〕 粗1, 1-ジフルオロエタン中に不純物として含まれる前記化合物の総含有量が0.1vol%以下である上記〔1〕～〔3〕のいずれかに記載の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

【0015】

〔5〕 粗1, 1-ジフルオロエタンと前記吸着剤とを接触させる圧力が1MPa以下である上記〔1〕～〔4〕のいずれかに記載の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

【0016】

〔6〕 精製された1, 1-ジフルオロエタン中に不純物として含まれる前記化合物の総含有量が100volppm以下である上記〔1〕～〔5〕に記載の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

【0017】

〔7〕 精製された1, 1-ジフルオロエタン中に不純物として含まれる分子内に2個の炭素原子を含む不飽和化合物類の総含有量が50volppm以下である上記〔1〕～〔6〕のいずれかに記載の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

【0018】

〔8〕 精製された1, 1-ジフルオロエタン中に不純物として含まれる分子内に2個の炭素原子を含む飽和含塩素化合物類の総含有量が50volppm以下である上記〔1〕～〔7〕のいずれかに記載の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

【0019】

〔9〕 粗1, 1-ジフルオロエタンが以下の(1)～(3)の工程を含む方法により得られたものである上記〔1〕～〔8〕のいずれかに記載の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法。

【0020】

(1) 1, 1-ジクロロエタンおよび／または1-クロロ-1-フルオロエタンとフッ化水素とを、フッ素化触媒の存在下に反応させて、主として1, 1-ジフルオロエタンを

得る工程

(2) 工程(1)で得られた1, 1-ジフルオロエタンを含む生成物中より、フッ化水素、1, 1-ジクロロエタンおよび／または1-クロロ-1-フルオロエタンを分離し、反応工程に循環する工程

(3) 工程(1)で得られた1, 1-ジフルオロエタンを含む生成物中より、塩化水素および／または1, 1-ジフルオロエタンを蒸留し、分離する工程

【10】 上記【1】～【9】のいずれかに記載の方法を用いて精製された1, 1-ジフルオロエタンであって、含有される水分が5 vol ppm以下である1, 1-ジフルオロエタン製品。

【0021】

【11】 上記【1】～【9】のいずれかに記載の方法を用いて精製された1, 1-ジフルオロエタンであって、含有されるフッ化水素が2 vol ppm以下である1, 1-ジフルオロエタン製品。

【0022】

【12】 上記【10】または【11】に記載の1, 1-ジフルオロエタン製品を含むことを特徴とする冷媒。

【0023】

【13】 上記【10】または【11】に記載の1, 1-ジフルオロエタン製品を含むことを特徴とするエッチングガス。

【発明の効果】

【0024】

本発明によれば、高純度な1, 1-ジフルオロエタンを簡便な方法で、効率的に製造することができ、得られた精製1, 1-ジフルオロエタンは低温用冷媒やエッチングガスとして使用することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0025】

以下、本発明の好ましい態様について詳しく説明する。

【0026】

前述したように、 CH_3CHF_2 の製造方法としては、例えば、(1) クロロエチレンや1-クロロ-1-フルオロエタン等を気相でフッ素化触媒を用いてフッ素化する方法、

(2) 塩素化フッ素化炭化水素を触媒の存在下に水素で還元して製造する方法等が知られている。これらの方法を用いて CH_3CHF_2 を製造すると、一般的に行なわれる蒸留操作などによる精製を行った場合であっても、 CH_3CHF_2 と分離することが困難な不純物が含まれる。これらの不純物としては、例えば、ハイドロカーボン(HC)類、ハイドロクロロカーボン(HCC)類、クロロフルオロカーボン(CFC)類、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)類、ハイドロフルオロカーボン(HFC)類が挙げられ、これらの不純物をできる限り除去して高純度化する必要がある。

【0027】

本発明の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法は、分子内に2個の炭素原子を含む不飽和化合物類および分子内に2個の炭素原子を含む飽和含塩素化合物類からなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物を含有する粗1, 1-ジフルオロエタンと、平均細孔径が3～6 Åであり、かつ、シリカ／アルミニウム比が2.0以下であるゼオライトおよび／または平均細孔径が3.5～6 Åである炭素質吸着剤とからなる吸着剤を接触させ、粗1, 1-ジフルオロエタン中に不純物として含まれる前記化合物の含有量を低減させることを特徴とする。

【0028】

粗1, 1-ジフルオロエタンに不純物として含まれる、分子内に2個の炭素原子を含む不飽和化合物類としては、例えば、エチレン、フルオロエチレン、塩化ビニルおよび塩化ビニリデンからなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物が挙げられる。また、分子内に2個の炭素原子を含む飽和含塩素化合物類としては、例えば、ジクロロエタン、1-ク

ロローー1-フルオロエタンおよび2-クロローー1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタンからなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物が挙げられる。これらの不純物を含む粗1, 1-ジフルオロエタンは、公知の蒸留操作のみによって精製することが困難であり、そこで本発明者らは吸着剤の極性や細孔径などを考慮し、吸着剤の種類や吸着条件などを変化させる等の検討を重ねた。

【0029】

その結果、平均細孔径が3~6Åであり、かつ、シリカ／アルミニウム比(Si/AI)が2.0以下であるゼオライトと接触させることにより、前記の不純物を選択的に吸着して除去することができることを見出した。シリカ／アルミニウム比が2.0以下であっても、平均細孔径が3Å未満であるか、または6Åを超えるゼオライトでは、前記の不純物を低減する効果は認められなかった。また、平均細孔径が3~6Åの範囲であっても、シリカ／アルミニウム比が2.0を超えるゼオライトにも前記の不純物を低減する効果は認められなかった。

【0030】

また、平均細孔径が3.5~6Åである炭素質吸着剤(例えば、モレキュラーシーピングカーボン)と接触させることにより、前記の不純物を選択的に吸着して除去することができることを見出した。しかし、平均細孔径が3.5Å未満であるか、または6Åを超える炭素質吸着剤を用いた場合には、前記の不純物を低減する効果は認められなかった。例えば、平均細孔径が3.5Å程度の活性炭は一般に使用され、強い吸着能を有することが知られているが、前記の不純物を低減する効果は認められなかった。

【0031】

前記のゼオライトや前記の炭素質吸着剤は、それぞれ単独で使用されてもよく、あるいは両者を任意の割合で組み合わせて使用されてもよい。

【0032】

粗1, 1-ジフルオロエタン中に不純物として含まれる前記の不純物の総含有量は0.1v01%以下であることが好ましく、さらに好ましくは0.05v01%である。不純物の総含有量が0.1v01%を超えると、吸着剤の使用量が多くなり、1, 1-ジフルオロエタンのロスや設備費等が高くなり、好ましくない。

【0033】

本発明の1, 1-ジフルオロエタンの精製方法において、前記不純物を含有する粗1, 1-ジフルオロエタンを前記吸着剤と接触させる方法は、特に限定されず、例えば、気相で接触させる方法、あるいは液相で接触させる方法のいずれの方法も可能であるが、液相で接触させる方法が効率がよく好ましい。また、液相で接触させる方法としては、回分式や連続式などの公知の方法を用いることができ、例えば、固定床式吸着塔を2基設け、一方の吸着塔が飽和吸着に達すると、これを切りかえて再生する方法を用いることができる。粗1, 1-ジフルオロエタンと吸着剤とを接触させる圧力は1MPa以下が好ましく、1MPaより大きい圧力では設備費が高くなり好ましくない。

【0034】

粗1, 1-ジフルオロエタンを前記のように処理し、精製して得られた1, 1-ジフルオロエタン中に不純物として含まれる前記化合物の総含有量は100v01ppm以下となり、高純度な製品が得られる。また、精製された1, 1-ジフルオロエタン中に不純物として含まれる、分子内に2個の炭素原子を含む不飽和化合物類の総含有量は50v01ppm以下であり、分子内に2個の炭素原子を含む飽和含塩素化合物類の総含有量も50v01ppm以下である。すなわち、精製された1, 1-ジフルオロエタンの純度は、99.99v01%以上である。

【0035】

粗1, 1-ジフルオロエタンは、

(1) 1, 1-ジクロロエタンおよび/または1-クロローー1-フルオロエタンとフッ化水素とを、フッ素化触媒の存在下に反応させて主として1, 1-ジフルオロエタンを得る工程、

(2) 工程(1)で得られた1, 1-ジフルオロエタンを含む生成物中より、フッ化水素、1, 1-ジクロロエタンおよび／または1-クロロ-1-フルオロエタンを分離し、反応工程に循環する工程、および

(3) 工程(1)で得られた1, 1-ジフルオロエタンを含む生成物中より、塩化水素および／または1, 1-ジフルオロエタンを蒸留し、分離する工程
を含む方法により得られる粗1, 1-ジフルオロエタンであることが好ましい。

【0036】

工程(1)は、例えば、1, 1-ジクロロエタンを出発原料とし、フッ素化触媒の存在下にフッ化水素によるフッ素化反応を行って粗1, 1-ジフルオロエタンを得る方法を用いることができる。フッ素化触媒としては、三価の酸化クロムを主成分とする担持型触媒または塊状型触媒が好ましい。

【0037】

工程(2)において、工程(1)で得られた1, 1-ジフルオロエタンを含む生成物を第1蒸留塔に導入し、塔頂留出物（主として塩化水素、1, 1-ジフルオロエタン）と塔底留出物として主としてフッ化水素、1, 1-ジクロロエタンと1-クロロ-1-フルオロエタンを分離し、塔底留出物を反応工程に循環することが好ましい。

【0038】

工程(3)において、工程(1)で得られた1, 1-ジフルオロエタンを含む生成物を第1蒸留塔に導入し、塔頂留出物として塩化水素と1, 1-ジフルオロエタンを回収し、これを第2蒸留塔に導入し、塔頂より主として塩化水素を留出させ、塔底より主として1, 1-ジフルオロエタンを留出させ、その後、前記記載の精製方法を実施することが好ましい。

【0039】

また、より好ましくは工程(3)の第2蒸留塔の塔底留出物である主として1, 1-ジフルオロエタン中に含まれる共沸分の酸分、主としてフッ化水素をアルカリ水溶液や水等で洗浄することが好ましく、より好ましくは洗浄後、脱水工程を設けることがよく、その後、前記記載の精製方法を実施するのがよい。

【0040】

前記の精製後の1, 1-ジフルオロエタンは、前述の如く、純度99.99 vol%以上を有しており、特に水分は5 vol ppm以下、フッ化水素（酸分）は2 vol ppm以下である。

【0041】

1, 1-ジフルオロエタン中に含まれる不純物の含有量の測定は、ガスクロマトグラフ(GC)法のTCD法、FID法あるいはガスクロマトグラフー質量計(GC-MS)法等により実施することができ、酸分はイオンクロマト法、水分はカールフィッシャー法等により測定することができる。

【0042】

さらに、高純度の1, 1-ジフルオロエタンは、冷媒用途以外に、1, 1-ジフルオロエタン、He、N₂、Ar等の不活性ガス、HCl、O₂、H₂等との混合ガスは、半導体デバイス製造工程におけるエッチング工程のエッチングガスとして用いることができる。LSIやTFT、有機EL等の半導体デバイスの製造プロセスでは、CVD法、スピターリング法、あるいは蒸着法などを用いて薄膜や厚膜を形成し、回路パターンを形成するためにエッチングを行なう際、前述の1, 1-ジフルオロエタンを含むガスをエッチングガスとして用いることができる。1, 1-ジフルオロエタンを用いるエッチング方法は、プラズマエッチング、マイクロ波エッチング等の各種ドライエッチング条件で実施することができる。

【実施例】

【0043】

以下、実施例および比較例により本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

【0044】

粗1, 1-ジフルオロエタンの調製例1（原料例1）

触媒（三価の酸化クロムを主成分とする）が充填されている反応器に1, 1-ジクロロエタンとフッ化水素を導入し、温度290℃で反応させ、主として1, 1-ジフルオロエタン、塩化水素および／または未反応のフッ化水素を主成分とするガスを生成させ、蒸留操作等により、フッ化水素、塩化水素を除去し、粗1, 1-ジフルオロエタンを得た。

【0045】

得られた粗1, 1-ジフルオロエタンをガスクロマトグラフで分析したところ、以下に示す組成を有していた。

【0046】

CH ₃ CHF ₂	99. 9461	CH ₂ = CH ₂	0. 0018
CH ₂ = CHF	0. 0143	CF ₃ CHC1F	0. 0013
CH ₂ = CHC1	0. 0261	CH ₃ CHC1F	0. 0089
CH ₂ = CCl ₂	0. 0012	CH ₃ CHC1 ₂	0. 0003

(単位: vol %)

また、得られた粗1, 1-ジフルオロエタン中の水分の含有量は25vol ppmであり、フッ化水素の含有量は6vol ppmであった。

【0047】

粗1, 1-ジフルオロエタンの調製例2（原料例2）

調製例1（原料例1）で得られた粗1, 1-ジフルオロエタンについて更に公知の方法にしたがって蒸留操作を行ない、粗1, 1-ジフルオロエタンを得た。

【0048】

得られた粗1, 1-ジフルオロエタンをガスクロマトグラフで分析したところ、以下に示す組成を有していた。

【0049】

CH ₃ CHF ₂	99. 9666	CH ₂ = CH ₂	0. 0006
CH ₂ = CHF	0. 0083	CF ₃ CHC1F	0. 0011
CH ₂ = CHC1	0. 0178	CH ₃ CHC1F	0. 0052
CH ₂ = CCl ₂	0. 0004		

(単位: vol %)

また、得られた粗1, 1-ジフルオロエタン中の水分の含有量は23vol ppmであり、フッ化水素の含有量は6vol ppmであった。

【0050】

実施例1

容積200mlのステンレス製シリンダーに、ゼオライト [モレキュラーシーブス5Å (ユニオン昭和株式会社製: 平均細孔径4.2Å, Si/A1比=1.0)] を20g充填し、真空乾燥後、シリンダーを冷却しながら原料例1の粗1, 1-ジフルオロエタンを約80g充填し、温度を-10℃に保ちながら時々攪拌し、約20時間後に液相部をガスクロマトグラフで分析したところ、以下に示す組成であった。

【0051】

CH ₃ CHF ₂	99. 9925	CH ₂ = CH ₂	0. 0001
CH ₂ = CHF	0. 0003	CF ₃ CHC1F	0. 0007
CH ₂ = CHC1	0. 0021	CH ₃ CHC1F	0. 0035
CH ₂ = CCl ₂	0. 0007	CH ₃ CHC1 ₂	0. 0001

(単位: vol %)

また、精製によって得られた1, 1-ジフルオロエタン中の水分の含有量をカールフィッシャー法（水分分析装置）により分析したところ3vol ppmであり、フッ化水素の含有量をイオンクロマト法により測定したところ1vol ppmであった。

【0052】

実施例2

容積200mlのステンレス製シリンダーに、炭素質吸着剤 [モレキュラーシーピングカーボン4A (武田薬品工業株式会社製:平均細孔径4Å)] を20g充填し、真空乾燥後、シリンダーを冷却しながら原料例1の粗1, 1-ジフルオロエタンを約80g充填し、温度を-20℃に保ちながら時々攪拌し、約18時間後に液相部をガスクロマトグラフで分析したところ、以下に示す組成であった。

【0053】

CH ₃ CHF ₂	99. 9975	CH ₂ =CH ₂	0. 0001
CH ₂ =CHF	0. 0005	CF ₃ CHC1F	0. 0002
CH ₂ =CHC1	0. 0011	CH ₃ CHC1F	0. 0004
CH ₂ =CC1 ₂	0. 0001	CH ₃ CHC1 ₂	0. 0001

(単位: v o l %)

実施例3

容積200mlのステンレス製シリンダーに、実施例1で用いたゼオライト [モレキュラーシーブス5A] 15gと実施例2で用いた炭素質吸着剤 [モレキュラーシーピングカーボン4A] 15gを混合して充填し、乾燥後、シリンダーを冷却しながら原料例2の粗1, 1-ジフルオロエタンを約100g充填し、温度を10℃に保ちながら時々攪拌し、約20時間後に液相部をガスクロマトグラフで分析したところ、以下に示す組成であった。

【0054】

CH ₃ CHF ₂	99. 9984	CH ₂ =CH ₂	0. 0001
CH ₂ =CHF	0. 0003	CF ₃ CHC1F	0. 0002
CH ₂ =CHC1	0. 0005	CH ₃ CHC1F	0. 0004
CH ₂ =CC1 ₂	0. 0001		

(単位: v o l %))

また、精製によって得られた1, 1-ジフルオロエタン中の水分の含有量は4v o l p p mであり、フッ化水素の含有量は1v o l p p mであった。

【0055】

実施例4

容積200mlのステンレス製シリンダーに、ゼオライト [モレキュラーシーブス4A (ユニオン昭和株式会社:平均細孔径3.5Å, Si/A1比=1.0)] を20g充填し、真空乾燥後、シリンダーを冷却しながら原料例2の粗1, 1-ジフルオロエタンを約80g充填し、温度を10℃に保ちながら時々攪拌し、約20時間後に液相部をガスクロマトグラフで分析したところ、以下に示す組成であった。

【0056】

CH ₃ CHF ₂	99. 9911	CH ₂ =CH ₂	0. 0002
CH ₂ =CHF	0. 0011	CF ₃ CHC1F	0. 0010
CH ₂ =CHC1	0. 0032	CH ₃ CHC1F	0. 0032
CH ₂ =CC1 ₂	0. 0002		

(単位: v o l %)

比較例1

容積200mlのステンレス製シリンダーに、ゼオライト [モレキュラーシーブス13X (ユニオン昭和株式会社製:平均細孔径10Å, Si/A1比=1.2)] を20g充填し、真空乾燥後、シリンダーを冷却しながら原料例2の粗1, 1-ジフルオロエタンを約80g充填し、温度を10℃に保ちながら時々攪拌し、約20時間後に液相部をガスクロマトグラフで分析したところ、以下に示す組成であった。

【0057】

CH ₃ CHF ₂	99. 9711	CH ₂ =CH ₂	0. 0006
CH ₂ =CHF	0. 0077	CF ₃ CHC1F	0. 0009
CH ₂ =CHC1	0. 0146	CH ₃ CHC1F	0. 0048
CH ₂ =CC1 ₂	0. 0003		

(単位：v o l %)

上記結果から明らかなように、Si/AI比が2.0以下でも、平均細孔径が6Åを超えるゼオライトでは、不純物を選択的に吸着除去することができないことが分かった。

【0058】**比較例2**

容積200m³のステンレス製シリンダーに、活性炭〔粒状白サギKL（武田薬品工業株式会社製：平均細孔径35Å）〕を20g充填し、真空乾燥後、シリンダーを冷却しながら原料例2の粗1, 1-ジフルオロエタンを約80g充填し、温度を10℃に保ちながら時々攪拌し、約20時間後に液相部をガスクロマトグラフで分析したところ、以下の組成であった。

【0059】

CH ₃ CHF ₂	99.9694	CH ₂ =CH ₂	0.0006
CH ₂ =CHF	0.0081	CF ₃ CHClF	0.0008
CH ₂ =CHCl	0.0166	CH ₃ CHClF	0.0044
CH ₂ =CCl ₂	0.0001		

(単位：v o l %)

上記結果から明らかなように、細孔径の大きい活性炭では、不純物を選択的に吸着除去することができないことが分かった。

【産業上の利用可能性】**【0060】**

本発明によれば、低温用冷媒やエッチングガスとして使用することができる、高純度な1, 1-ジフルオロエタンを工業的に有利に製造することができる。

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 低温用冷媒やエッティングガスとして使用することができる、高純度な1, 1-ジフルオロエタンを工業的に有利に製造することができる方法を提供する。

【解決手段】 分子内に2個の炭素原子を含む不飽和化合物類および分子内に2個の炭素原子を含む飽和含塩素化合物類からなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物を含有する粗1, 1-ジフルオロエタンと、平均細孔径が3～6Åであり、かつ、シリカ／アルミニウム比が2.0以下であるゼオライトおよび／または平均細孔径が3.5～6Åである炭素質吸着剤とからなる吸着剤を接触させ、粗1, 1-ジフルオロエタン中に不純物として含まれる前記化合物の含有量を低減させる。

【選択図】 なし

特願 2003-379784

出願人履歴情報

識別番号

[000002004]

1. 変更年月日 1990年 8月27日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都港区芝大門1丁目13番9号
氏名 昭和電工株式会社

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/016690

International filing date: 04 November 2004 (04.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2003-379784
Filing date: 10 November 2003 (10.11.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 10 February 2005 (10.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse